

高耐圧ゲートドライバー

2GM06KM/2GM06KS

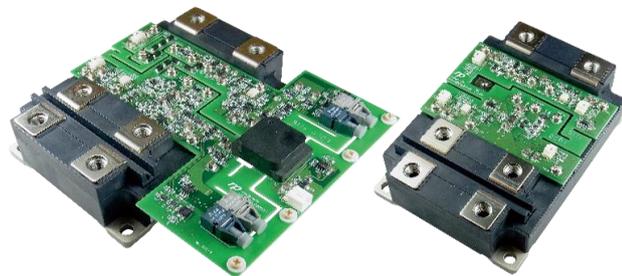
3300V・450Aクラス 4kHz
HVIGBTゲートドライバー 《2回路内蔵》

光ファイバー絶縁方式によるゲートドライブ回路と小型高耐圧トランスを内蔵したDCDCコンバータを1ユニット化した製品で、マスター(2GM06KM)・スレーブ(2GM06KS)方式により最大4並列駆動が可能です。

- 特長**
- 小型高耐圧トランス
 - 光ファイバー絶縁方式
 - IEC62497-1に準拠した絶縁距離



- 短絡検出
- 電圧低下検出
- 過熱検出



2GM06KM

2GM06KS

電気的特性 (Ta = 25 °C)	
特性項目	条件・定格
電源電圧	DC15V±0.5V
電源電流	0.7A typ.※1
入力信号周波数範囲	DC~4kHz
最小入力パルス幅	5 μs ※6
入力信号	HFBR-1522ETZ
最大ゲート駆動能力	1.3uC × 4ch/4kHz max., Rgon/off=6.8Ω / 12Ω
出力順バイアス電圧(+Vg)	+14V~+16V ※1
出力逆バイアス電圧(+Vg)	-14V~-16V ※1
ゲート順方向バイアス電流(+I _g)	+2.5A(P _{rw} ≤ 2 μs) max.
ゲート逆方向バイアス電流(-I _g)	-2A(P _{fw} ≤ 3 μs) max.
立上り応答遅れ時間(+T _{stg})	310ns typ ※1,3
立下り応答遅れ時間(-T _{stg})	320ns typ ※1,4
ゲート立上り時間(T _r)	1 μs typ. ※1,5
ゲート立下り時間(T _f)	1.5 μs typ. ※1,5
短絡検出電圧	20V min.
短絡検出ゲート停止時間	10ms typ. ※7
絶縁耐圧	AC6000V 1分間(入力-出力間)
部分放電開始電圧	AC2200V min. / 10pC(入力-出力間)
絶縁抵抗	DC1000Vにて20MΩ以上(入力-出力間)

環境条件	
動作温度範囲	-40~+60°C
保存温度範囲	-40~+85°C
動作・保存湿度範囲	30~90%RH(但し結露なきこと)

- ※1 Vin: DC15V, f: 4kHz, Duty: 50% 負荷: MBM450FS33FS相当の疑似負荷 6.2Ω + 0.0433 μF, 4並列駆動
- ※2 ブロック図に示す様に、R_{gon}/R_{goff}=6.8Ω / 12Ωを挿入してあります。
- ※3 入力信号の立上りから、出力ゲート信号波高値の10%までの時間
- ※4 入力信号の立下りから、出力ゲート信号波高値の90%までの時間
- ※5 出力ゲート信号の波高値10%⇔90%までの時間
- ※6 ゲート立ち上がりから、V_{ce}検出抑制を3 μs設けています。
- ※7 短絡検出後、Lowレベルを保持する時間
- ※8 スレーブドライバーの詳細はお問合せください。

端子配列

ピン番号	信号名	機能
CN1 53426-0210(molex)		
1	VDD	電源入力(+)
2	GND	電源入力(-)
HFBR-2522ETZ(BROADCOM)		
RX1A	FO1A	ゲート入力A(光)
RX1B	FO1B	ゲート入力B(光)
HFBR-1522ETZ(BROADCOM)		
TX1A	FO0A	ALM出力A(光)
TX1B	FO0B	ALM出力B(光)

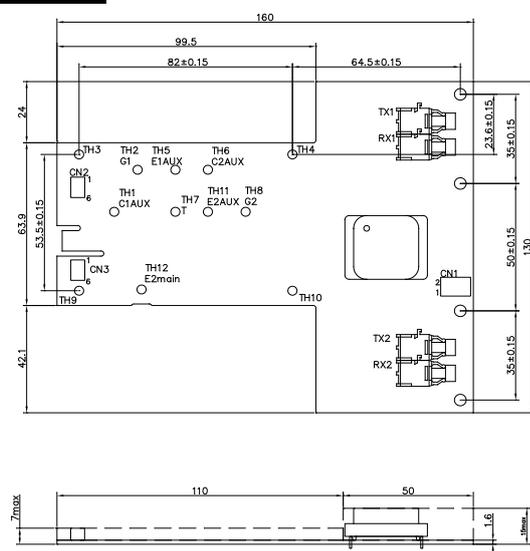
ピン番号	信号名	機能
M3用スレーブホール		
-	E1AUX	エミッタ出力A
-	G1	ゲート出力A
-	C1AUX	コレクタ入力A
-	C2AUX	コレクタ入力B
-	T	サーミスタ入力
-	G2	ゲート出力B
-	E2AUX	エミッタ出力B
-	E2main	エミッタ出力B

- 本カタログの内容について、弊社の許可なく転載及び複写することは禁止いたします。
- 品質保持・改良等により、予告なく仕様・仕様・外形等に変更する場合がございます。本カタログが、最新版かどうかにつきましては、弊社担当までお問い合わせください。
- カタログ製作には、最善かつ慎重を期しておりますが、誤字・脱字などにより生じた誤謬については、責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ご不明な点がございましたら、弊社担当までお問い合わせください。

※本製品にHVIGBTモジュールは付属しません。

寸法図

(mm)



ブロック図

